



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

RECEIVED
MAR 22 2001
In re Patent Application of:
Werner KLUFT IC 2800 MAIL ROOM.

Serial No: 09/708,660

Filed: November 9, 2000

#3 2877
3/30/01
Art Unit: 2877

Examiner:

METHOD AND DEVICE FOR MEASURING PROCESS
PARAMETERS OF A MATERIAL WORKING PROCESS

Certificate of Mailing

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231 on:
March 20, 2001

Box Response - No Fee
Assistant Commissioner of Patents
Washington, D.C. 20231

By: Vincent L. Ramik
Vincent L. Ramik

PRIORITY CLAIM

Sir:

Claim is hereby made on behalf of the above-noted Applicant for priority under the International Convention, based upon the corresponding European Patent Office Application No. 99 122 600.2 of November 12, 1999.

A certified copy is attached.

Respectfully submitted,

DILLER, RAMIK & WIGHT

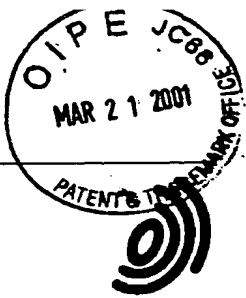
By: Vincent L. Ramik

Vincent L. Ramik, Reg. 20,663

7345 McWhorter Place; Suite 101
Annandale, Virginia 22003
(703) 642-5705 - phone
(703) 642-2117 - fax

Attachments: certified copy (1)

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches
Patentamt

Eur pean
Patent Office

Office eur péen
des brevets

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterla-
gen stimmen mit der
ursprünglich eingereichten
Fassung der auf dem näch-
sten Blatt bezeichneten
europäischen Patentanmel-
dung überein.

The attached documents
are exact copies of the
European patent application
described on the following
page, as originally filed.

Les documents fixés à
cette attestation sont
conformes à la version
initialement déposée de
la demande de brevet
européen spécifiée à la
page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

99122600.2

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

I.L.C. HATTEN-HECKMAN

DEN HAAG, DEN
THE HAGUE,
LA HAYE, LE

10/11/00

THIS PAGE BLANK (USPTO)



**Eur päisches
Patentamt**

**Eur pean
Patent Office**

**Office eur péen
des brevets**

**Blatt 2 der Bescheinigung
Sheet 2 of the certificate
Page 2 de l'attestation**

Anmeldung Nr.:
Application no.: 99122600.2
Demande n°:

Anmeldetag:
Date of filing: 12/11/99
Date de dépôt:

Anmelder:
Applicant(s):
Demandeur(s):
Kluft, Werner
D-52078 Aachen
GERMANY

Bezeichnung der Erfindung:
Title of the invention:
Titre de l'invention:

Verfahren und Vorrichtung zur Messung von Prozessparametern eines Materialbearbeitungsprozesses

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s) revendiquée(s)

Staat:
State:
Pays:

Tag:
Date:
Date:

Aktenzeichen:
File no.
Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation:
International Patent classification:
Classification internationale des brevets:

B23K26/03

Am Anmeldetag benannte Vertragsstaaten:
Contracting states designated at date of filing: AT/BE/CH/CY/DE/DK/ES/FI/FR/GB/GR/IE/IT/LI/LU/MC/NL/PT/SE/TR
Etats contractants désignés lors du dépôt:

Bemerkungen:
Remarks:
Remarques:

THIS PAGE BLANK (USPTO)

12-11-1999

12-11-1999

EP99122600.2

221 121992

49 89 239944

SPEC

Pat ntnanwälte Patent Attorneys

VON KREISLER SELTING WERNER

Deichmannhaus am Dom
D-50667 KÖLN

EPO - Munich
59

12. Nov. 1999

von Kreisler Selting Werner Postfach 102241 · D-50462 Köln
P.O. Box

Dr.-Ing. Werner Kluft
Ellerstr. 43

D-52078 Aachen

Patentanwälte

Dr.-Ing. von Kreisler † 1973

Dipl.-Chem. Alak von Kreisler

Dipl.-Ing. Günther Selting

Dipl.-Chem. Dr. Hans-Karsten Werner

Dipl.-Chem. Dr. Johann F. Fues

Dipl.-Ing. Georg Dallmeyer

Dipl.-Ing. Jochen Hillertingmann

Dipl.-Chem. Dr. Hans-Peter Jönsson

Dipl.-Chem. Dr. Hans-Wilhelm Meyers

Dipl.-Chem. Dr. Thomas Weber

Dipl.-Chem. Dr. Jörg Helbing

Unser Zeichen:
992513ep/Da/ru

Köln,
11. November 1999

Verfahren und Vorrichtung zur Messung von Prozeßparametern eines Materialbearbeitungsprozesses

Die Erfindung betrifft ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung zur Messung von Prozeßparametern eines Materialbearbeitungsprozesses nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. 14.

Hochenergiestrahlen, insbesondere Laserstrahlen werden in unterschiedlichster Weise zur Materialbearbeitung eingesetzt, nämlich beispielsweise zum Schneiden, Bohren und Schweißen unterschiedlichster Materialien und Werkstückgeometrien. Allen Verfahren ist gemeinsam, daß zur Bearbeitung das Werkstück aufgeschmolzen und/oder teilweise verdampft wird. Die Überführung des bearbeiteten Materials in unterschiedliche Aggregatzustände macht diese Bearbeitungsprozesse häufig anfällig für Materialfehler und Prozeßänderungen. Insbesondere Prozesse, in denen alle drei Aggregatzustände des Materials, nämlich fest, flüssig und dampfförmig durchlaufen werden, werden durch eine Vielzahl von Prozeßparametern beeinflußt.

- 2 -

Beim Laserstrahlschweißen sind die Prozeßparameter, die die Nahtgeometrie beeinflussen, nachstehend beispielhaft angegeben:

- Nahtvorbereitung:
z.B. Kantenvorbeutung, Materialpaarung, Stoßart
- Prozeßführung:
z.B. Verwendung eines Zusatzdrahtes, Vorschubgeschwindigkeit, Schutz- bzw. Arbeitsgas
- Eigenschaften der Bearbeitungseinrichtung:
z.B. Führung des Laserstrahls, Fokussieroptik, Reproduzierbarkeit der Schweißbahn
- Prozeßparameter der Lasereinrichtung:
z.B. Laserleistung, Stabilität der Laserleistung, Strahlqualität.

Darüber hinaus verlangt die Entwicklung im Automobilbau immer komplexere Bearbeitungsgeometrien, die eine Führung der Hochenergiestrahlung notwendig macht.

Um eine reproduzierbare Bearbeitungsqualität zu garantieren, ist eine Online-Überwachung des Bearbeitungsprozesses erforderlich, in der relevante Prozeßparameter gemessen werden und zur Steuerung bzw. Regelung des Materialbearbeitungsprozesses herangezogen werden.

Aus der DE 197 41 329 C ist ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Materialbearbeitung mit plasmainduzierter Hochenergiestrahlung bekannt, bei dem der Bereich der Dampfkapillare zur Steuerung und Überwachung des Bearbeitungsprozesses beispielsweise mit einer CCD-Kamera überwacht wird. Dabei ist vorgesehen, den

- 3 -

Bereich der Dampfkapillaren an mindestens zwei Meßstellen zu untersuchen, um unterschiedliche Kapillargeometriegrößen zu erfassen. Zur Auswertung werden demzufolge bestimmte Bildbereiche des von der CCD-Kamera übertragenen Bildes zur Bestimmung der Kapillargeometriegrößen ausgewertet. Da zunächst die gesamten Bilddaten der Auswerteeinrichtung zugeführt werden müssen, ist eine Messung mit hoher Überwachungsfrequenz nicht möglich. Desweiteren erlaubt das bekannte Verfahren nicht die Untersuchung des Umfeldes der Dampfkapillaren, so daß weitere voneinander unabhängige Überwachungs- und Steuerungssysteme erforderlich sind, um eine optimierte Prozeßführung zu ermöglichen.

Der Erfindung liegt demzufolge die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die die gleichzeitige Erfassung mehrerer Prozeßparameter mit einer einzigen Überwachungseinrichtung und mit einer hohen Überwachungsfrequenz zu ermöglichen.

Zur Lösung dieser Aufgabe dienen die Merkmale des Anspruchs 1 bzw. 14.

Die Erfindung sieht in vorteilhafter Weise vor, daß ein optischer Sensor mit einem Dynamikbereich über 70 dB verwendet wird. Ein derartiger Sensor ist in der Lage, gleichzeitig den Bereich der Dampfkapillaren, die die Dampfkapillare umgebende Schmelzzone und ggf. auch eine die Schmelzzone umgebende Randzone simultan zu erfassen und erlaubt die Auswertung der Meßsignale trotz des hohen Kontrastumfangs des erzeugten Bildes. Dadurch ist es möglich, Meßsignale von unterschiedlichen Ausschnitten des Bildfeldes zur Bestimmung der Prozeßparameter simultan auszuwerten. Da nur die Meßsignale von Ausschnitten des Bildfeldes der Auswerteeinrichtung zugeführt werden, kann eine hohe Überwachungsfrequenz von über 1 kHz erreicht werden, da

- 4 -

die zur Auswertung gelangende MeßsignalDatenmenge gering gehalten wird.

In dem von dem optischen Sensor erfaßten Bildfeld werden vorzugsweise unterschiedliche Bildausschnitte frei wählbar festgelegt, wobei ausschließlich die Meßsignale dieser Bildausschnitte simultan zur Bestimmung unterschiedlicher zu Überwachender Prozeßparameter verwertet werden.

Die freie Wählbarkeit der Bildausschnitte ermöglicht ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Einrichtung eines Überwachungssystems. Die Beobachtung bestimmter Bereiche der Schmelzzone ist insofern von großer Bedeutung, da die Schmelze von der heißeren Region um die Dampfkapillare herum zum entfernteren Ende der Schmelzzone getrieben wird. Dort kühlt sich dieser Bereich ab und erstarrt schließlich. Dabei erfolgt offensichtlich ein unregelmäßiger Transport heißen Materials, der die Erstarrung der Schmelze beeinflusst und zu Unregelmäßigkeiten und Fehlern in der Resultierenden Schweißnaht führen kann. Eine Beobachtung der Erstarrungsfront am Ende der Schmelzzone ist daher für eine Überwachung von Fehlern, die mit der Erstarrung des Materials zusammenhängen, z.B. Oberflächenrauhigkeit, Nahtüberhöhungen, Löcher, Oberflächenporen u.s.w., wesentlich. Die Überwachung dieser Fehler wäre allein mit der Überwachung der Dampfkapillaren nicht möglich.

Meßsignale von Bildausschnitten im Bereich der Schmelzzone vor und seitlich der Dampfkapillaren können zur Überwachung von Nahtvorbereitungsfehlern verwendet werden.

Meßsignale eines Bildausschnittes in Arbeitsrichtung vor der Bearbeitungszone im Bereich der Schmelzzone oder in dem der Schmelzzone vorgelagerten Randbereich können zur Messung der

- 5 -

Nahtlage und zur Steuerung der Laserposition oder Werkstückposition verwendet werden. Eine Kombination der Kapilarüberwachung, der Schmelzzonenüberwachung und der Nahtverfolgung hat für den Anwender den Vorteil, daß alle Überwachungs- und Steuerungsfunktionen mit einem einzigen Überwachungs- und Steuerungssystem durchgeführt werden können, wobei gleichzeitig die Bedienung der Steuerung vereinfacht wird.

Die Eindringtiefe des Hochenergiestrahls kann aus einer reduzierten Anzahl von Bildpixeln eines Bildausschnitts im Zentrum der Dampkapillaren ermittelt werden.

Die Meßsignale eines Bildausschnittes in Bearbeitungsrichtung hinter der Dampkapillaren in der Schmelzzone und/oder in Bearbeitungsrichtung in einem Randbereich hinter der Schmelzzone kann zur Messung der Oberflächentopographie des bearbeiteten Werkstücks verwendet werden.

Für spezielle Überwachungsaufgaben ist es möglich, in dem Strahlengang zu dem optischen Sensor einen Filter vorzusehen, mit dem Licht vorbestimmter Wellenlängen ausgefiltert werden kann.

Als optischer Sensor wird bevorzugt eine CMOS-Kamera verwendet. Die CMOS-Technologie ermöglicht es, Bildpixel des Bildfeldes unabhängig von dem Gesamtbild auszuwerten, wodurch in vorteilhafter Weise die Anzahl der zu verarbeitenden Meßsignaldaten auf ein Mindestmaß reduziert werden kann. Es ist nicht erforderlich, alle Meßsignaldaten zunächst aufzunehmen und erst anschließend selektiv auszuwerten. Auf diese Weise ist eine hohe Überwachungsfrequenz bis über 1 kHz möglich.

- 6 -

Dabei wird vorzugsweise ein optischer Sensor mit einem Dynamikbereich von über 100 dB verwendet.

Die Fokussierposition des Hochenergiestrahls kann durch Messung der Lichtintensitätsänderung in einem linienförmigen oder rechteckförmigen Bildausschnitt bestimmt werden, der linear durch die Dampfkapillare und die benachbarten beiderseitigen Schmelzonen verläuft.

Weitere vorteilhafte Merkmale der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Im folgenden werden unter Bezugnahme auf die Zeichnungen Ausführungsbeispiele der Erfindung näher erläutert:

Es zeigen:

- Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung,
- Fig. 2 das von einer CMOS-Kamera erzeugte Bildfeld mit ausgewählten Bildausschnitten,
- Fig. 3 ein Beispiel für die Bestimmung Fokusslage eines Laserlichtstrahls, und
- Fig. 4 Beispiele unterschiedlicher Bearbeitungsfehler.

Fig. 1 zeigt die Bearbeitung eines Werkstücks 8 mit einem Laserstrahl 2, der mit Hilfe eines Umlenkspiegels 4 und eines Fokussierspiegels 6 auf das Werkstück 8 fokussiert wird. Ob rhalb des Umlenkspiegels 6 ist eine CMOS-Kamera 10 mit einer Optik 12 angeordnet, die durch den Umlenkspiegel 6 hindurch koaxial zu

- 7 -

dem fokussierten Laserlichtstrahl 2 die Bearbeitungszone des Werkstücks 8 beobachtet. Hierzu kann der Umlenkspiegel 6 eine entsprechende Perforation für den Strahlendurchgang aufweisen oder ist für die untersuchten Lichtwellenlängen zumindest teilweise durchlässig. In der Zeichnung ist schematisch der Meßstrahl 3 innerhalb des Meßkegels 5 der CMOS-Kamera 10 dargestellt, mit dem die in dem Werkstück 8 erzeugte Dampfkapillare 14 hinsichtlich der emittierten Lichtintensität abgetastet wird. Die Dampfkapillare 14 entsteht durch Erhitzen und Verdampfen des Materials des Werkstücks 8 und bildet eine räumliche Vertiefung in dem Werkstück 8, deren Kapillargeometrie Größen mit Hilfe der CMOS-Kamera 10 und einer Auswerteeinrichtung 18 zwecks Prozeßsteuerung oder Prozeßregelung verwertet werden. Über den Strahlengang 3 hinaus erfaßt der Meßkegel 5 der CMOS-Kamera ein Bildfeld, das nicht nur die Dampfkapillare 14 enthält, sondern darüber hinaus die die Dampfkapillare 14 umgebende Schmelzzone 20 und einen Randbereich jenseits der Schmelzzone 20 im Vorfeld der Bearbeitung und im Bereich der Schweißnaht 17. Die in Fig. 1 dargestellte Plasmawolke 31 ist für die vorgesehenen Messungen durchsichtig.

Wie in Fig. 1 ersichtlich, ist bei der schematischen Darstellung vorausgesetzt, daß das Werkstück 8 relativ zu dem Hochenergiestrahle 2 in Richtung des Pfeils bewegt wird. Selbstverständlich kann das Werkstück 8 auch feststehend sein und in die Einrichtung zum Erzeugen von Hochenergiestrahlen, z.B. eine Lasereinrichtung, bewegt werden.

Zwischen der CMOS-Kamera 10 und dem Umlenkspiegel 6 kann ein Filter 15 angeordnet sein, wenn bestimmte Lichtwellenlängen von der Messung ausgeschlossen werden sollen.

- 8 -

Die CMOS-Kamera 10 weist einen Dynamikbereich von ca. 120 dB auf, so daß simultan sowohl die Gasphase als auch die Schmelzphase und ggf. auch die feste Phase eines Werkstücks 6 während der Bearbeitung meßtechnisch beobachtet werden kann.

Die CMOS-Technologie ermöglicht es einzelne Bildpixel unabhängig von den Gesamtinformationen des Bildfeldes auszuwerten, so daß lediglich bestimmte frei wählbare Bildausschnitte innerhalb des von der Kamera abgetasteten Bildfeldes und des von der Kamera erzeugten Bildes der Verwertung durch die Auswerteeinrichtung 18 zugeführt werden. Um on-line eine Überwachungsfrequenz von mindestens 1 kHz alle zur Überwachung und Steuerung notwendigen Prozeßgrößen zu ermitteln und auszuwerten wird eine Datenreduktion vorgenommen. Dies geschieht anhand von spezifischen Merkmalen, die für die entsprechenden Prozeßgrößen charakteristisch sind.

Z.B. kann die Eindringtiefe des Laserstrahls 2 in das Werkstück 8 anhand von wenigen Bildpixeln ermittelt, auf die die Strahlung aus dem Zentrum der Dampfkapillaren 14 abgebildet wird.

Fig. 2 zeigt das von der CMOS-Kamera 10 überwachte Bildfeld, das den Bereich der Dampfkapillaren 14, den Bereich der Schmelzzone 20 und den die Schmelzzone 20 umgebenden Randbereich einschließt. In dem Bild sind deutlich die dampfförmigen, flüssigen und erstarrten Bereich unterscheidbar. Im Bereich der Dampfkapillaren 14 kann, wie am besten Fig. 1 ersichtlich ist, auch eine Plasmawolke 31 vorhanden sein.

Eine Beobachtung der Erstarrungsfront am Ende der Schmelzzone 20 kann für eine Überwachung von Fehlern, die mit der Erstarrung des Materials zusammenhängen, von Bedeutung sein. Beispielsweise können Fehler hinsichtlich der Oberflächenrauig-

- 9 -

keit, Nahtüberhöhung, hinsichtlich Löcher oder Oberflächenporen bestehen.

Derartige Bearbeitungsfehler entstehen bei der Erstarrung des Materials im Schmelzbad des Bearbeitungsprozesses. Diese Fehler werden zwar grundsätzlich innerhalb der direkten Wechselwirkungszone zwischen dem Laserstrahl 2 und dem Werkstück 8 erzeugt, können dort in der Regel aber nicht beobachtet werden. Insofern ist die simultane Beobachtung der Schmelzzone 20 oder bestimmte Bildausschnitte der Schmelzzone 20 von großer Bedeutung.

In Fig. 2 sind verschiedene Bildausschnitte 23 bis 30 dargestellt, die dazu dienen, unterschiedliche Prozeßparameter des Bearbeitungsprozesses zu überwachen. Beispielsweise dient der Bildausschnitt 27 zu einer Überwachung von Fehlern aus der Nahtvorbereitung. In diesem Fall kann die Beobachtung auf den Bildausschnitt 25 beschränkt werden. Um eine schnelle Online-Überwachung zu ermöglichen, werden nur die Pixel aus den entsprechend ausgewählten Bereichen mit möglichst einfachen Algorithmen analysiert, wie beispielsweise die Gesamtintensität des Bereiches oder die Differenz in der Intensität zwischen zwei Pixeln. Mit den Bildausschnitten 26 und 28 kann die Eindringtiefe des Laserstrahls überwacht werden. Mit dem Bildausschnitt 28 kann eine erhebliche Datenreduktion durchgeführt werden indem beispielsweise eine Pixelreihe quer zur Bearbeitungsrichtung im Bereich der Dampfkapillaren 14 den Dampfkapillarbereich überwacht. Mit dem Bildausschnitt 24 kann ein Positionierungsfehler, wie er aus Fig. 4 rechts unten ersichtlich ist, überwacht werden.

- 10 -

Mit dem Bildausschnitt 30 ist die Überwachung der Oberflächen-topographie der soeben hinter der Schmelzzone 20 erstarrten Be-arbeitungszone möglich.

Mit dem Bildausschnitt 23 ist beispielsweise die Nahtverfolgung möglich, so daß der Bearbeitungsprozeß komplizierten Konturen folgen kann, indem eine vorgegebene Bahn abgetastet wird und der Laserstrahl 2 entsprechend gesteuert wird.

Mit dem Bildausschnitt 29, der mit dem Bildausschnitt 28 dek-kungsgleich sein kann, aber auch unter einem Winkel zu dem Bildausschnitt 28 verlaufen könnte, kann die Fokusposition des Laserstrahls überwacht werden. Hierzu wird ebenfalls ein schma-ler Bildausschnitt ausgewählt, der sich quer durch die Dampfka-pillare 14 erstreckt.

Fig. 3 zeigt vier unterschiedliche Fokuspositionen und oberhalb der bildlichen Darstellungen sind die Meßsignale über die Länge des Bildauschnittes 29 dargestellt. Dabei wird die erste Ablei-tung der Meßsignalwerte zur Beurteilung der Fokuslage herange-zogen, also letztlich die Änderungsrate der Lichtintensität längs des Bildausschnitts 29. Das rechte Bild in Fig. 3 zeigt die optimale Fokusposition, die durch zwei ausgeprägte Maximal-werte gekennzeichnet ist. Überwacht wird dabei das Erreichen eines Maximalwertes.

Fig. 4 zeigt vier Anwendungsbeispiele für das beschriebene Ver-fahren. Das Bild links oben in Fig. 4 zeigt die korrekte Posi-tion zwischen zwei zu verschweißenden Werkstücken 8,9, wobei unterhalb des zweiten Werkstücks 9 ein drittes hitzeempfindli-ches Teil 11 angeordnet ist. In diesem Fall kommt es darauf an, die Eindringtiefe des Laserlichtstrahls 2 exakt zu kontrollie-ren.

- 11 -

Das Bild rechts oben in Fig. 4 zeigt einen Fehler der Nahtvorbereitung, bei dem die miteinander zu verbindenden Werkstücke 8 und 9 unter einem Winkel α zur Achse des Laserlichtstrahls 2 verlaufen. In diesem Fall kann mit der Überwachung der Fokussposition leicht festgestellt werden, daß die Fokusslage sich verändert hat und somit offensichtlich ein Einspannfehler hinsichtlich der Werkstücke 8,9 vorliegt.

Das Bild unten links in Fig. 4 zeigt einen ungewollten Versatz zwischen dem ersten Werkstück 8 und dem zweiten Werkstück 9, so daß es in der Bearbeitungszone zu einer ungewollten Durchschweißung kommen kann. Ein solcher Bearbeitungsfehler kann beispielsweise mit dem Bildausschnitt 27 überwacht werden.

Die Abbildung rechts unten in Fig. 4 zeigt einen Bearbeitungsfehler, bei dem der Laserlichtstrahl unbeabsichtigt das zweite Werkstück 9 berührt. Ein derartiger Bearbeitungsfehler kann mit dem in Fig. 2 gezeigten Bildausschnitt 24 überwacht werden.

12 Nov. 1999

Patentansprüche

1. Verfahren zur Messung von Prozeßparametern eines Materialbearbeitungsprozesses mit einem auf eine Bearbeitungszone eines Werkstücks (8) fokussierten Hochenergiestrahl (2), insbesondere Laserstrahl, durch Messen der Lichtintensität koaxial zur Hochenergiestrahlung in der Bearbeitungszone im Bereich einer von dem Hochenergiestrahl (2) erzeugten Dampfkapillaren (14) mittels eines optischen Sensors (10), der ein Bildfeld abtastet und dessen Meßsignale einer Auswerteeinrichtung (18) zugeführt werden,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein optischer Sensor (10) mit einem Dynamikbereich von über 70 dB verwendet wird, und
daß Meßsignale von Ausschnitten des Bildfeldes im Bereich der Dampfkapillaren (14) und zumindest auch im Bereich der die Dampfkapillare (14) umgebenden Schmelzzone (20) simultan der Auswerteeinrichtung (18) zugeführt werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in dem von dem optischen Sensor (10) erfaßten Bildfeld unterschiedliche Bildausschnitte (24 bis 29) frei wählbar festgelegt werden, und daß ausschließlich die Meßsignale dieser Bildausschnitte zur simultanen Bestimmung unterschiedlicher zu überwachender Prozeßparameter verwertet werden.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßsignale von Bildausschnitten (27) im Bereich der Schmelzzone (20) vor oder seitlich der Dampfkapillaren (14) zur Überwachung von Nahtvorbereitungsfehlern verwendet werden.

- 13 -

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßsignale eines Bildausschnittes (23) in Arbeitsrichtung vor der Bearbeitungszone in der Schmelzzone (20) oder in dem der Schmelzzone (20) vorgelagerten Randbereich zur Messung der Nahtlage und zur Steuerung der Laserposition oder der Werkstückposition verwendet werden.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Eindringtiefe des Hochenergiestrahls (2) aus einer reduzierten Anzahl von Bildpixeln eines Bildausschnitts (28) im Zentrum der Dampfkapillaren (14) ermittelt wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßsignale eines Bildausschnittes (30) in Bearbeitungsrichtung hinter der Dampfkapillaren (14) in der Schmelzzone (20) und/oder in Bearbeitungsrichtung hinter der Schmelzzone (20) zur Messung der Oberflächentopographie des bearbeiteten Werkstücks (6) verwendet werden.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßdaten aus den unterschiedlichen Bildausschnitten (23 bis 30) einer Datenreduktion zugeführt werden.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß Licht vorbestimmter Wellenlängen in dem Strahlengang zum optischen Sensor (10) ausgefiltert wird.

- 14 -

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß als optischer Sensor (10) eine CMOS-Kamera verwendet wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß simultan durch Messung der Lichtintensität in der Dampfkapillaren (14) Kapillarkenngrößen und durch Messung der Lichtintensität mindestens einer ausgewählter Stelle der Schmelzzone (20) Kenngrößen des Schmelzbades ermittelt werden, wobei eine Steuerung des Bearbeitungsprozesses in Abhängigkeit von den ermittelten Kapillarkenngrößen und den ermittelten Kenngrößen des Schmelzbades erfolgt.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß ein optischer Sensor (10) mit einem Dynamikbereich über 100 dB verwendet wird.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Fokussierposition des Hochenergiestrahls (2) durch Messung der Lichtintensitätsänderung in einem linienförmigen oder rechteckförmigen Bildausschnitt (29) bestimmt wird, der durch die Dampfkapillare (14) und die benachbarten Schmelzzonen (20) verläuft.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßsignale von ausgewählten Bildpunkten zur Überwachung, Prozeßsteuerung oder Prozeßregelung verwendet werden.
14. Vorrichtung zur Messung von Prozeßparametern eines Materialbearbeitungsprozesses, mit einer Einrichtung zum Erzeugen eines Hochenergiestrahls (2), z.B. eines Laser-

- 15 -

strahls, mit einer Fokussiereinrichtung (6) zum Fokussieren des Hochenergiestrahls (2) auf eine Bearbeitungszone eines Werkstücks (8) und mit einem optischen Sensor zur Messung der Lichtintensität der in der Bearbeitungszone entstehenden Dampfkapillaren, wobei der Sensor (10) koaxial zur Richtung des Hochenergiestrahls (2) auf die Bearbeitungszone des Werkstücks (8) fokussiert ist, sowie mit einer Auswerteeinrichtung (18) zur Auswertung der von dem optischen Sensor (10) gelieferten Meßsignale des abgetasteten Bildfeldes,

dadurch gekennzeichnet,

daß der optische Sensor (10) einen Dynamikbereich von über 70 dB aufweist und Meßsignale aus dem Bereich der Dampfkapillaren (14) und mindestens auch einen Bereich der die Dampfkapillare (14) umgebenden Schmelzzone (20) an die Auswerteeinrichtung (18) überträgt.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswerteeinrichtung nur Meßsignale von Bildausschnitten des Bildfeldes erhält, die außer den Bereich der Dampfkapillaren (14) mindestens einen Bereich der die Dampfkapillare (14) umgebenden Schmelzzone (20) erfassen.
16. Vorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daß der optische Sensor (10) aus einer CMOS-Kamera besteht.
17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswerteeinrichtung (18) die Bildsignale in mehreren unterschiedlichen Bildausschnitten (24 bis 30) des von dem Sensor (10) abgetasteten Bildfeldes im Hinblick auf vorbestimmte Prozeßparameter auswertet.

- 16 -

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswerteeinrichtung (18) im Bereich der Dampfkapillaren (14) eine vorbestimmte reduzierte Anzahl von in der Nähe des Hochenergiestrahls (2) angeordneten Bildpunkten zwecks Messung der Eindringtiefe des Hochenergiestrahls erfaßt.
19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswerteeinrichtung (18) die Meßsignale in Bildausschnitten (24,27) im Bereich des Schmelzbades (20) in Bearbeitungsrichtung hinter und seitlich der Dampfkapillaren (14) zur Messung von Nahtvorbereitungsfehlern auswertet.
20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswerteeinrichtung (18) die Meßsignale in Bildausschnitten in Bearbeitungsrichtung hinter der Dampfkapillaren (14) in der Schmelzzone oder in Bearbeitungsrichtung hinter der Schmelzzone (20) zur Messung der Oberflächentopographie auswertet.
21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswerteeinrichtung (18) die Meßsignale aus einem sich linien- oder rechteckförmig durch die Dampfkapillare (14) und die benachbarte Schmelzzone (20) erstreckenden Bildausschnitt (29) zur Bestimmung der Fokussierposition des Hochenergiestrahls (2) auswertet.
22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß das im Strahlengang zu dem optischen Sensor (10) ein Filter (15) angeordnet ist, mit dem vorbe-

12-11-1999

EP99122600.2

SPEC

- 17 -

stimmte Wellenlängen des aufgenommen Lichtes ausblendbar
sind.

Zusammenfassung

12 Nov. 1999

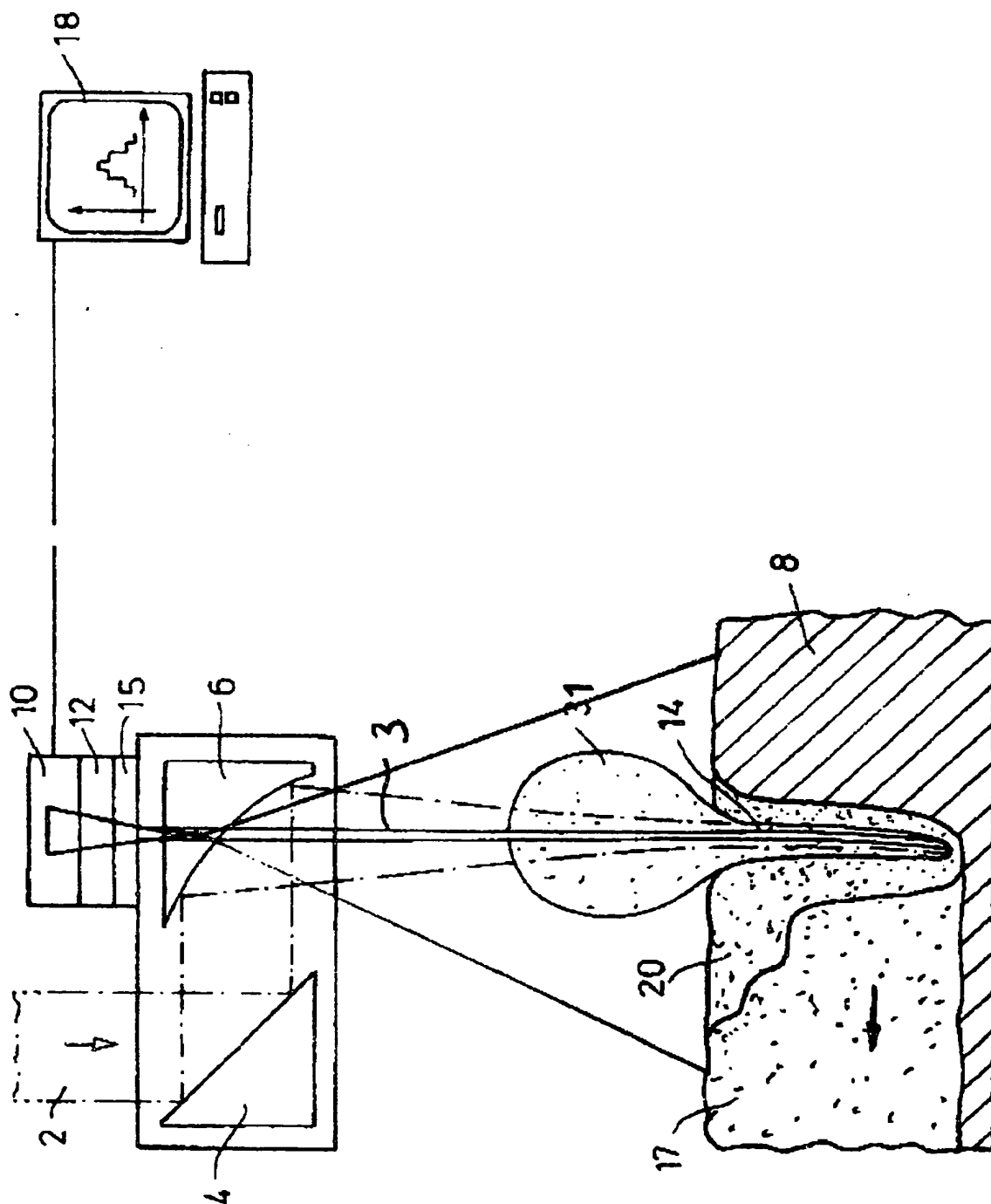
Verfahren und Vorrichtung zur Messung von Prozeßparametern eines Materialbearbeitungsprozesses

Bei einem Verfahren zur Messung von Prozeßparametern eines Materialbearbeitungsprozesses mit einem auf eine Bearbeitungszone eines Werkstücks (8) fokussierten Hochenergiestrahl (2), insbesondere Laserstrahl, durch Messen der Lichtintensität koaxial zur Hochenergiestrahlung in der Bearbeitungszone im Bereich einer von dem Hochenergiestrahl (2) erzeugten Dampfkapillaren (14) mittels eines optischen Sensors (10), der ein Bildfeld abtastet und dessen Meßsignale einer Auswerteeinrichtung (18) zugeführt werden, ist vorgesehen, daß ein optischer Sensor (10) mit einem Dynamikbereich von über 70 dB verwendet wird, und daß Meßsignale von Ausschnitten des Bildfeldes im Bereich der Dampfkapillaren (14) und zumindest auch im Bereich der die Dampfkapillare (14) umgebenden Schmelzzone (20) simultan der Auswerteeinrichtung (18) zugeführt werden.

(Fig. 1)

EPO-Munich
59

12 Nov. 1999

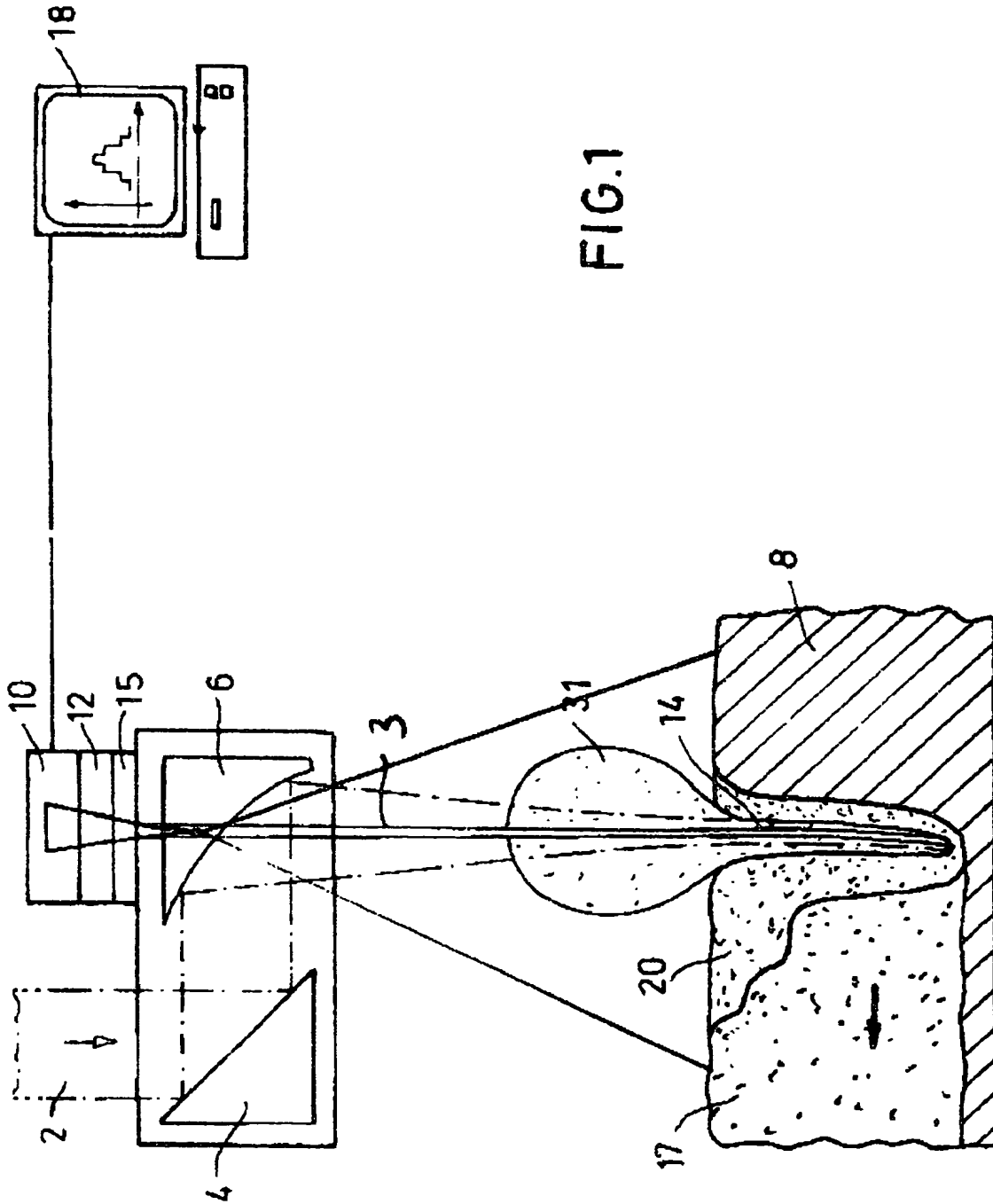


- 1 / 4 -

EPO - Munich
59

12 Nov. 1999

FIG.1



- 2 / 4 -

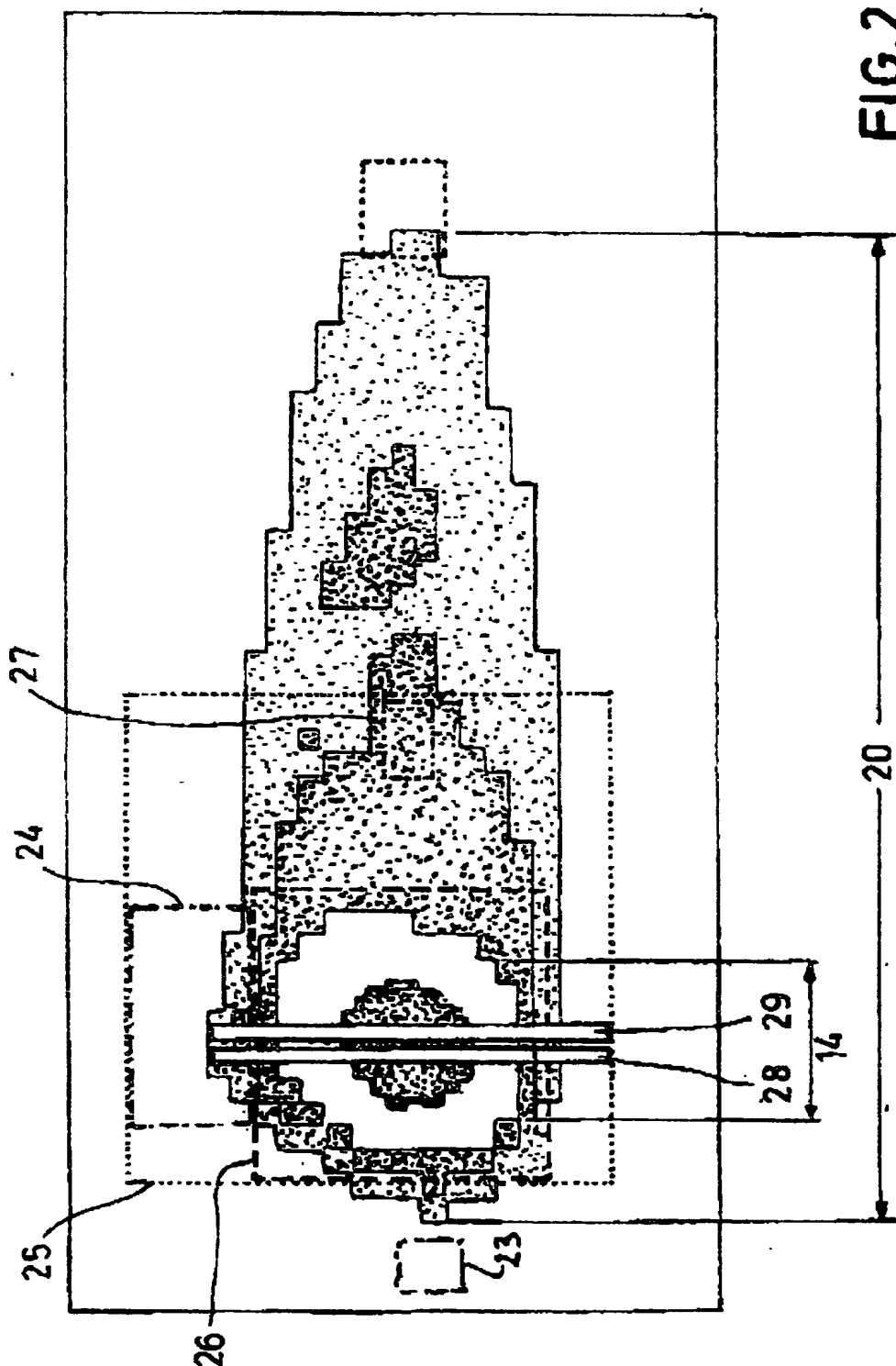


FIG. 2

-3/4-

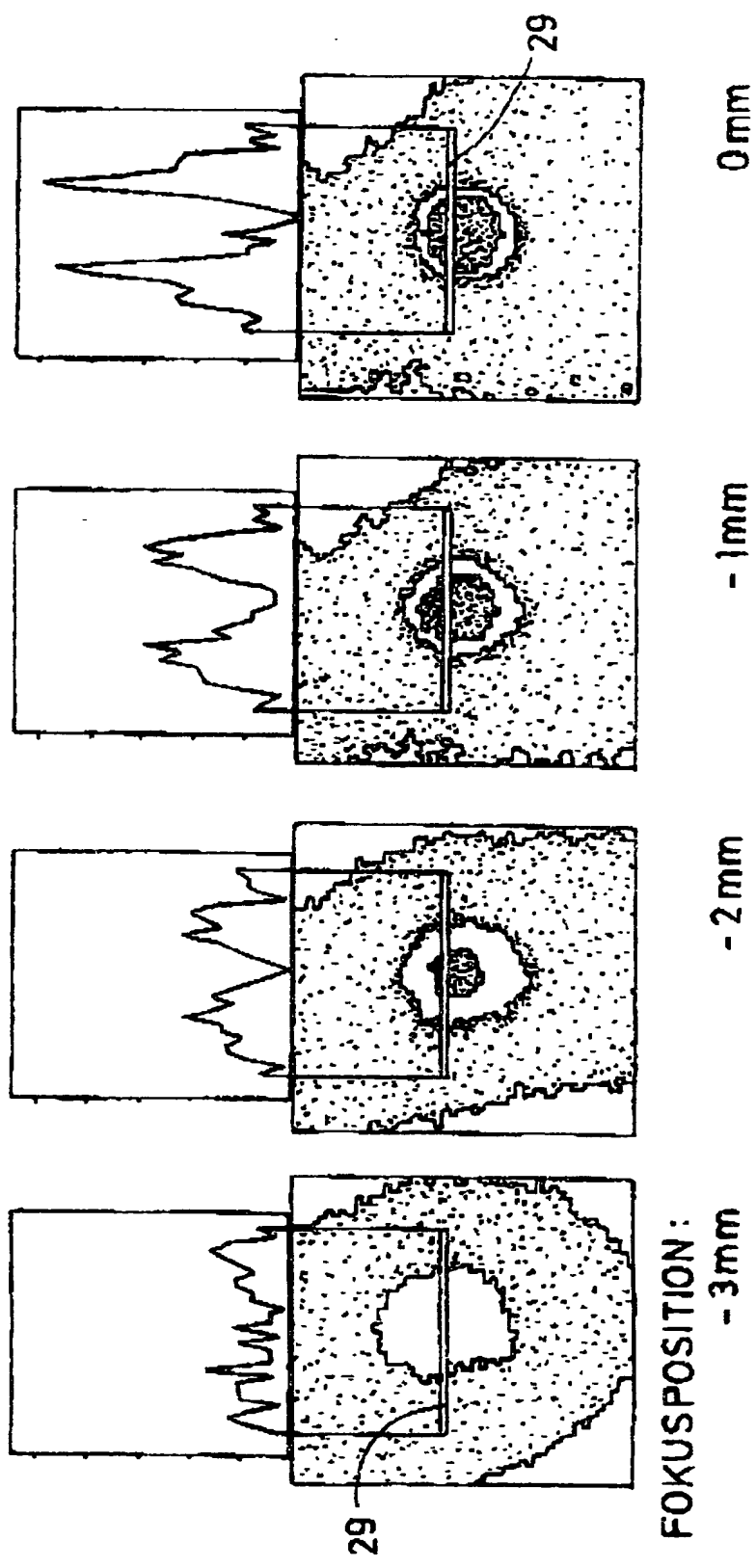


FIG.3

FOCUS POSITION :

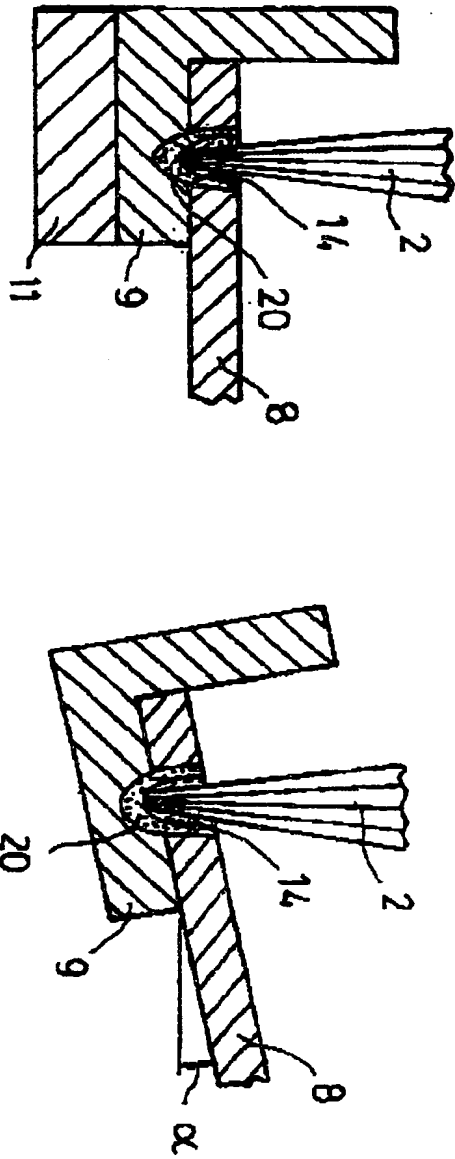
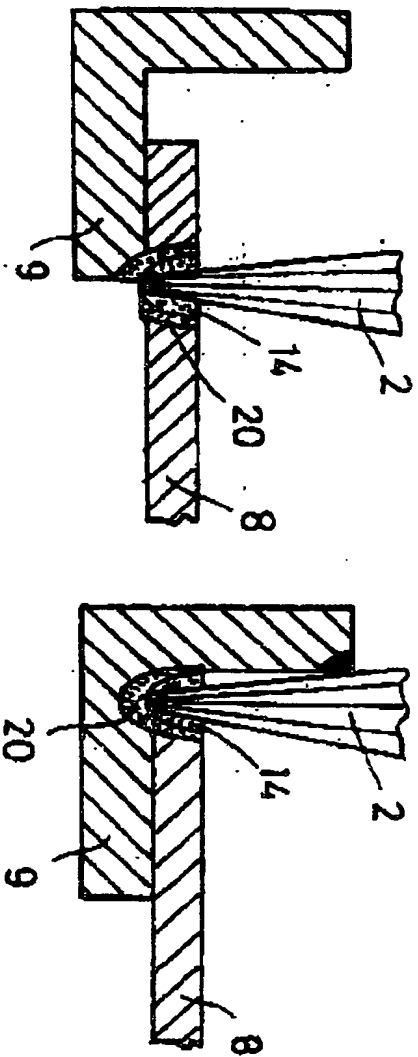


FIG. 4



THIS PAGE BLANK (USPTO)